

特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

(法第 12 条、法施行規則第 56 条)
[PCT36 条及び PCT 規則 70]

REC'D 09 DEC 2005

WIPO

PCT

出願人又は代理人 の書類記号 EL04021PCT—	今後の手続きについては、様式 PCT/IPEA/416 を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2004/018066	国際出願日 (日.月.年) 03.12.2004	優先日 (日.月.年) 04.12.2003
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. H01L21/3065(2006.01)		
出願人 (氏名又は名称) 東京エレクトロン株式会社		

1. この報告書は、PCT35 条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。
法施行規則第 57 条 (PCT36 条) の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。

3. この報告には次の附属物件も添付されている。

a. 附属書類は全部で ページである。

指定されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面の用紙 (PCT 規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照)

第 I 欄 4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとの国際予備審査機関が認定した差替え用紙

b. 電子媒体は全部で ページである。
(電子媒体の種類、数を示す)。
配列表に関する補充欄に示すように、電子形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。
(実施細則第 802 号参照)

4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

第 I 欄 国際予備審査報告の基礎
 第 II 欄 優先権
 第 III 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
 第 IV 欄 発明の單一性の欠如
 第 V 欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
 第 VI 欄 ある種の引用文献
 第 VII 欄 国際出願の不備
 第 VIII 欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 28.09.2005	国際予備審査報告を作成した日 22.11.2005
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号	特許庁審査官 (権限のある職員) 菅野 智子 電話番号 03-3581-1101 内線 3471
	4R 3339

第I欄 報告の基礎

1. 言語に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。

- 出願時の言語による国際出願
- 出願時の言語から次の目的のための言語である _____ 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文
- 國際調査 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))
- 國際公開 (PCT規則12.4(a))
- 國際予備審査 (PCT規則55.2(a)又は55.3(a))

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

- 出願時の国際出願書類

- 明細書

第 _____ ページ、出願時に提出されたもの
 第 _____ ページ*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
 第 _____ ページ*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

- 請求の範囲

第 _____ 項、出願時に提出されたもの
 第 _____ 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの
 第 _____ 項*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
 第 _____ 項*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

- 図面

第 _____ ページ/図、出願時に提出されたもの
 第 _____ ページ/図*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
 第 _____ ページ/図*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

- 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. 振正により、下記の書類が削除された。

明細書 第 _____ ページ
 請求の範囲 第 _____ 項
 図面 第 _____ ページ/図
 配列表 (具体的に記載すること)
 配列表に関するテーブル (具体的に記載すること) _____

4. この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した振正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その振正がされなかつたものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

明細書 第 _____ ページ
 請求の範囲 第 _____ 項
 図面 第 _____ ページ/図
 配列表 (具体的に記載すること)
 配列表に関するテーブル (具体的に記載すること) _____

* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	7, 11, 12, 15-21	有
	請求の範囲	1-6, 8-10, 13, 14	無
進歩性 (I S)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1-21	無
産業上の利用可能性 (I A)	請求の範囲	1-21	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

国際調査報告で引用した文献

文献1:JP 2003-224185 A (松下電器産業株式会社)
2003.08.08, 段落【0020】-【0082】, 第1-6図
文献2:JP 2003-258090 A (富士通株式会社)
2003.09.12, 段落【0025】-【0108】 , 第1-23図

請求の範囲 1, 3-6, 8-10, 13, 14

文献1には、誘導結合型、マイクロ波型等のプラズマ反応室に置かれた半導体基板上の導電層表面を清浄化する方法であって、前記反応室内で水素、アルゴン、ヘリウム等のプラズマを発生させ、前記導電層表面をこのプラズマによって還元しながら清浄化する清浄化方法が記載されているから、請求の範囲1, 3-6, 8-10, 13, 14に記載された発明は、新規性、進歩性を有しない。

請求の範囲 1-4

文献2には、反応室内に置かれた半導体基板上の導電層表面を清浄化する方法であって、前記反応室内で水素プラズマを発生させ、前記導電層表面を前記プラズマによって還元し、前記導電層表面上に存在する残渣有機物を除去する清浄化方法が記載されているから、請求の範囲1-4に記載された発明は、新規性、進歩性を有しない。

請求の範囲 7

文献1には記載の水素に対するヘリウムの比率を0.005~20の範囲に選択することは、当業者にとって容易である。

請求の範囲 11, 12

文献1に記載のプラズマ処理装置において、プラズマ密度を $10^{10} \sim 10^{13}/\text{cm}^3$ にすること、及び、プラズマの電子密度を0.7~5eVにすることは、当業者にとって容易である。

請求の範囲 15, 17-21

文献1に記載の清浄化方法を実行するソフトウェアを記憶した記録媒体とは、当業者にとって自明である。

請求の範囲 15-18

文献2に記載の清浄化方法を実行するソフトウェアを記録した記録媒体とは、当業者にとって自明である。